SEMICONDUCTOR LASER DEVICE	
Patent Number:	JP5021899
Publication date:	1993-01-29
Inventor(s):	SAKUKAI MASASHI; others: 02
Applicant(s):	NEC CORP
Requested Patent:	☐ <u>JP5021899</u>
Application Number:	JP19910198331 19910715
Priority Number(s):	
IPC Classification:	H01S3/18
EC Classification:	
Equivalents:	

PURPOSE:To commonly fabricate optical modules each with different optical outputs by effectually utilizing two exit lights from a semiconductor laser device including reflective films of different reflectivities. CONSTITUTION:A semiconductor laser device 1 including reflective films of different reflectivities formed on opposite exit end surfaces thereof is fixed on a stem 3 having a heat radiation function. The semiconductor laser device is hermetically sealed in a cap 4 having two opposite glass windows 5, 5 by fixing the cap 4 to the side of the stem. In this case, the two emitting end faces of semiconductor laser device are disposed facing to the two glass windows located on the side of the cap.

Abstract

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-21899

(43)公開日 平成5年(1993)1月29日

(51) Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01S 3/18

9170-4M

審査請求 未請求 請求項の数4(全 3 頁)

(21)出願番号

特願平3-198331

(22)出願日

平成3年(1991)7月15日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 朔晦 正志

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72)発明者 松本 清人

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72)発明者 安藤 晴康

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

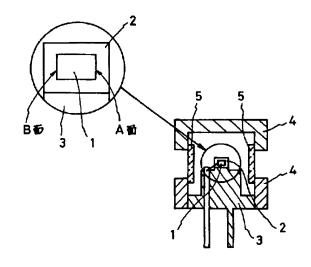
(74)代理人 弁理士 山川 政樹

(54) 【発明の名称】 半導体レーザ装置

(57)【要約】

【目的】 反射率の異なる反射膜を形成した半導体レー ザ素子の二つの出射光を有効に活用し、光出力が異なる 光モジュールを共通化して製造可能とする。

【構成】 放熱機能を有するステム3上に、両出射端面 に反射率の異なる反射膜が形成されている半導体レーザ 素子1を固定する。また、相対向する二枚のガラス窓 5. 5を有するキャップ4をステム側に固定することに より、その内部に半導体レーザ素子を気密封止する。こ の場合に、半導体レーザ素子の二つの出射端面を、キャ ップ側の二枚のガラス窓を向けて配置させる。



【特許請求の範囲】

Ċ,

【請求項1】 出射光を外部へ通過させる透明なガラス 窓を有するパッケージで気密封止された半導体レーザ装 置において、放熱機能を有するステムと、このステム上 に固定されかつ両出射端面に反射率の異なる反射膜が形 成されている半導体レーザ素子と、相対向する二枚のガ ラス窓を有するキャップとを備えてなり、前記半導体レ ーザ素子の二つの出射面を、前記二枚のガラス窓を向け て配置したことを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項2】 請求項1において、半導体レーザ素子の 10 二つの出射面と二枚のガラス窓とが、互いに平行関係に ないことを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項3】 請求項1において、半導体レーザ素子を 気密封止するキャップに、二枚のガラス窓の高出力側と 低出力側を確認するためのマーキングを付したことを特 徴とする半導体レーザ装置。

【請求項4】 請求項1において、キャップに設けられ る二枚のガラス窓の少なくとも一面には、反射防止膜が 施されていることを特徴とする半導体レーザ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は半導体レーザ装置に関 し、特に通信用光モジュールに搭載して好適な半導体レ ーザ装置の改良に関する。

[0002]

【従来の技術】従来この種の半導体レーザ装置として は、概略図3に示すような構成によるものが知られてい た。これを簡単に説明すると、この半導体レーザ装置 は、ヒートシンク15に固定された半導体レーザ素子1 4と、モニタ用フォトダイオード16とが、ステム17 に固定されており、かつその外側に覆われるガラス窓1 9を有するキャップ18により気密封止されている。ま た、半導体レーザ素子14の両端面には、反射率の異な る反射膜が形成されており、高反射率の反射膜が形成さ れた端面からの低出力の出射光は、モニタ用フォトダイ オード16に結合し、低反射率の反射膜が形成された端 面からの高出力の出射光はガラス窓19からキャップ1 8の外部に出射されるように構成されていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し たような従来の半導体レーザ装置を用いてなる通信用光 モジュールでは、長距離光通信用と短距離光通信用とで 光モジュールに要求される光出力が異なるため、それぞ れの光モジュールに適した光学系を設計する必要があ り、かつ使用する光学部品がそれぞれの場合で異なるた めに、構成部材等の共通化ができないという問題があっ た。

【0004】本発明はこのような事情に鑑みてなされた ものであり、反射率の異なる反射膜が形成された半導体 レーザ素子の二つの出射光を有効に活用し、光出力が異 50 【0009】他方、この図2に示した半導体レーザ装置

なる光モジュールを共通部品、共通工法によって製造す ることができる半導体レーザ装置を得ることを目的とし ている。

[0005]

【課題を解決するための手段】このような要請に応える ために本発明に係る半導体レーザ装置は、放熱機能を有 するステム上に固定されかつ両出射端面に反射率の異な る反射膜が形成されている半導体レーザ素子と、相対向 する二枚のガラス窓を有するキャップとを備えてなり、 このキャップは、前記半導体レーザ素子を気密封止して ステム側に固定され、かつ前記半導体レーザ素子の二つ の出射面は、前記キャップの二枚のガラス窓に向けて配 置されているものである。

[0006]

【作用】本発明によれば、半導体レーザ素子の二つの射 出面からの光を出射するキャップの二枚のガラス窓のい ずれか一方に、フォトダイオードを有するパッケージ を、他方にレンズ、光ファイバ等からなる出力側部材を 付設することにより、低出力光出射側または高出力光出 20 射側を選択的に使用でき、光出力の異なる光モジュール が共通部品、共通工法で製造でき、量産効果による大幅 なコストダウンが実現し得るものである。

[0007]

【実施例】図1は本発明に係る半導体レーザ装置の一実 施例を示すものであり、図において、符号1は両端面に 反射率の異なる反射膜が形成された半導体レーザ素子で あり、この半導体レーザ素子1は、ヒートシンク2を介 してステム3に固定されている。そして、この半導体レ ーザ素子1の両端面からの出射光を取出すための相対向 する二つのガラス窓5を備えたキャップ4により気密封 止されている。ここで、半導体レーザ素子1の低反射率 の反射膜が形成された端面(A面)からの高出力出射光 と高反射率の反射膜が形成された端面 (B面) からの低 出力出射光はそれぞれキャップ4のガラス窓5から出射 される。

【0008】図2は上述したような本発明に係る半導体 レーザ装置を使用した半導体レーザモジュールで、この 例では高出力光モジュールを示している。これを簡単に 説明すると、半導体レーザ装置6の高出力光出射側に は、レンズ7を固定したレンズホルダ8が固定され、半 導体レーザ装置7からの出射光がレンズ8を介して光フ ァイバ9に結合するように、光ファイバ9を固定したス リープ10とスリープ10を保持するホルダ11、およ びホルダ11とレンズホルダ8が調整して固定される。 一方、半導体レーザ装置6の低出力光出射側には、フォ トダイオード12を搭載したパッケージ13が固定され る。そして、このような構成によって、半導体レーザ装 置6を用いてなる高出力光用の光モジュールが得ること は容易に理解されよう。

3

を用いた高出力光モジュールとは逆に、半導体レーザ装置6の低出力光出射側に、出力側部材であるレンズ?を固定したレンズホルダ8、光ファイパ9を内蔵したスリーブ10、およびスリーブ10を保持しレンズホルダ8に固定するホルダ11を調整して固定し、また高出力光出射側に、フォトダイオード12を内蔵したパッケージ13を固定すると、低出力光用の光モジュールが得られるものである。

【0010】そして、このような構成によれば、半導体レーザ素子1の二つの射出面からの光を出射するキャップの二枚のガラス窓5,5のいずれか一方に、フォトダイオード12を有するパッケージ13を、他方にレンズ7、光ファイパ9等からなる出力側部材を適宜付設することで、低出力光出射側または高出力光出射側を選択的に使用でき、高出力、低出力の二種類のレーザ光を、簡単に外部に取り出せるため、用途に応じて高出力光モジュールと低出力光モジュールの使い分けができ、部品の共通化、製造工程の共通化が行なえ、その結果として量産効果による大幅なコストダウンが実現し得るものである。

る。

[0012]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る半導体レーザ装置によれば、高出力、低出力の二種類のレーザ光を外部に取り出せるため、用途に応じて高出力光モジュールと低出力光モジュールの使い分けができ、部品の共通化、製造工程の共通化が行える。したがって、本発明によれば、量産効果による大幅なコストダウンが実現できるという種々優れた効果がある。

10 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る半導体レーザ装置の一実施例を示す要部縦断面図である。

【図2】本発明に係る半導体レーザ装置を採用した光モジュールを示す概略構成図である。

【図3】従来の半導体レーザ装置を示す概略断面図である。

【符号の説明】

- 1 半導体レーザ素子
- 2 ヒートシンク
- 20 3 ステム
 - 4 キャップ
 - 5 ガラス窓
 - 6 半導体レーザ装置
 - 7 レンズ
 - 8 レンズホルダ
 - 9 光ファイバ
 - 10 スリープ
 - 11 ホルダ
 - 12 フォトダイオード
- 30 13 パッケージ

